

$$\epsilon = K \epsilon_0$$

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{libre}}{\epsilon} \quad \text{para dielectrics}$$

(a)  $a < r < b$  (dentro del dielectrico)  $\rightarrow$   $Q_{libre}$ : carga que esta libre y no pertenece atada a una molecula (osea no tiene orisen por apantallamiento)  
En este caso  $Q_{libre} = Q$

$$\rightarrow \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{libre}}{\epsilon}$$

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon} \rightarrow \vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}$$

Noten que es  $\epsilon$  del material no  $\epsilon_0$ !

(b)  $r > b \rightarrow$  afuera del dielectrico entonces esta en el vacio  
uso Gauss de forma "tipica"

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{libre}}{\epsilon_0} \rightarrow \vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Noten que  $\epsilon_0$  es el del vacio

(c)

$$V(r) - V_\infty = \int_a^r \vec{E} \cdot d\vec{x} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} dr + \int_b^\infty \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr =$$

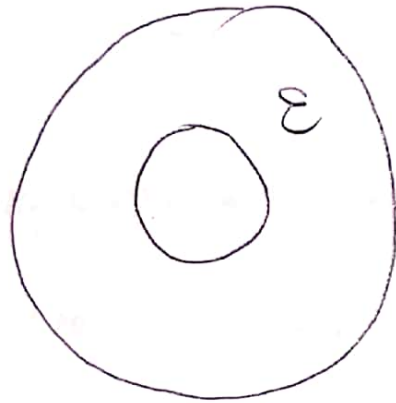
$$= \left. -\frac{Q}{4\pi \epsilon r} \right|_a^b - \left. \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r} \right|_b^\infty = \frac{-Q}{4\pi} \left( \frac{1}{\epsilon r} \Big|_a^b + \frac{1}{\epsilon_0 r} \Big|_b^\infty \right)$$

$$= -\frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{\epsilon} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{\epsilon_0} \left( -\frac{1}{b} \right) \right)$$

$$= -\frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{b} \left( \frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) - \frac{1}{\epsilon_0 a} \right)$$

$$= \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{b} \left( \frac{1}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon} \right) + \frac{1}{\epsilon_0 a} \right)$$

→ capacitancia



$$\rightarrow C = \frac{Q}{V}$$

con  $V$  entre  $a$  y  $b$  como  $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

$$C = \frac{Q}{\left( \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left( \frac{a-b}{ab} \right) \right)}$$

$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{(a-b)}$$